

平成28年度 基盤研究（S） 審査結果の所見

研究課題名	界面スピン軌道結合の微視的解明と巨大垂直磁気異方性デバイスの創製
研究代表者	三谷 誠司（国立研究開発法人物質・材料研究機構・磁性スピントロニクス材料研究拠点・グループリーダー） ※平成28年6月末現在
研究期間	平成28年度～平成32年度
審査結果の所見	<p>応募者らは、界面スピン軌道結合の学術基盤の構築と、新規スピン軌道デバイスの創出を目指して、①高度な界面構造の作製制御、②電子磁気分光の深化、③相対論的第一原理計算のループにより、新規デバイス・新規評価技術の確立を目指している。具体的には、界面構造制御技術、軌道状態を計測する新しい磁気分光法、界面の第一原理計算を融合した磁性体ヘテロ構造界面のスピン軌道結合を探索するもので、精密な結晶作製技術によって、理論解析と比較しうる良質の結晶界面を実現していること、得意分野が異なる研究代表者と研究分担者の協力体制が良くできていることなどを評価し、本研究は基盤研究（S）として採択すべき課題であると判断した。</p>